公司代码:688416 公司简称:恒烁股份

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 -9,949.39 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,424.15 万元。2025 年,尽管受益于行业景气度提升及公司积极的市场策略带来营收增长和毛利率同比改善,同时资产减值损失显著减少,但由于公司全年综合毛利率仍处于较低水平,且期间费用率保持高位,公司本年度亏损虽较上年收窄,但尚未扭转亏损。

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -9,949.39 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 -27,929.65 万元。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度拟不分配利润,不派发现金红利,以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 14,812,925.60 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 14.89%。

上述 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经第二届董事会第十四次会议审议通过,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至 2025 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 -27,929.65 万元,主要系近几年受存储行业周期波动、主营产品价格下滑,公司综合毛利率较低、计提资产减值损失和期间费用相较于营收规模较高等综合因素影响。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	恒烁股份	688416	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周晓芳	肖倩倩
联系地址	合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼	合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼
电话	0551-65673252	0551-65673252
传真	0551-65673252	0551-65673252
电子信箱	Zbitsemi@zbitsemi.com	Zbitsemi@zbitsemi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

(1)、主要业务情况

公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片、基于 Arm? Cortex?-M0+ 内核架构的通用 32 位 MCU 芯片、大容量存储产品业务和 AI 芯片业务(通用 AI SoC 芯片、AI 算法模型和 AI 模组板卡)。

(2)、主要产品

(2.1)NOR Flash 存储芯片

公司 NOR Flash 产品在制程、电压、功耗、频率、工作温度及产品稳定性等方面均处于行业主流水平,部分产品技术水平达到行业先进水平。

公司自主研发的 NOR Flash 产品,采用高速串行外设接口(SPI)技术,具备高可靠性、低功耗特性、良好的兼容性和成本效益等特点。

①技术工艺:公司的 NOR Flash 产品采用了业界广泛认可的浮栅工艺(Floating Gate 工艺,也称为 ETOX 工艺)。这种基于 ETOX 的 NOR Flash 技术完全拥有国内自主知识产权,无需依赖外部技术授权。经过长期和广泛的客户验证,该技术已证明其在可靠性和稳定性方面的卓越表现。同时,公司也对 NORD 架构的 NOR Flash 产品进行研发,致力于保持产品及技术领先。

②制程技术:目前销售的主要 NOR Flash 产品采用了武汉新芯的 50nm 制程技术,以及中芯国际的 55nm 制程技术。除部分特殊工规等产品保留 65nm 工艺节点,其他全系 NOR Flash 产品,已全面过渡到 5Xnm 工艺节点,以提高产品性能和生产效率。

③容量选择:能够提供从 1Mb 到 512Mb 的 NOR Flash 产品系列,以满足不同容量需求的市场。

④工作电压:公司 NOR Flash 产品根据工作电压可分为三个系列:低电压(1.65~2.0V)、高电压(2.3~3.6V)以及宽电压(1.65~3.6V),全面覆盖了市场上主要的工作电压等级。

⑤性能参数:公司的 NOR Flash 产品支持最高 166MHz 的工作频率,在双线(SPI Dual Mode)和四线(SPI Quad Mode)的工作模式下,数据传输带宽可分别达到 332Mbits/s 和 664Mbits/s。在双边沿数据传输模式下,数据带宽更是高达 532Mbits/s,静态电流低至 1μA,工作温度范围标准为 -40℃至 125℃,数据保持时间长达 20 年,擦写次数可达 10 万次,确保了产品的长期稳定性和耐用性。

⑥车规认证:部分 NOR Flash 产品已通过 AEC-Q100 的标准认证,公司将致力于实现车规产品全容量系列的认证,以满足汽车行业对高可靠性存储解决方案的需求。

综上所述,公司的 NOR Flash 产品在制程技术、工作电压范围、功耗控制、操作频率、工作温度适应性以及产品稳定性方面均处于行业领先水平,部分产品技术已达到行业先进水平,能够为客户提供了高性能和高可靠性的存储解决方案。

(2.2)通用 MCU 芯片

公司目前销售的 ZB32L002、ZB32L003、ZB32L030、ZB32L032 系列共计 30 余款型号产品,均为基于 Arm Cortex-M0+ 内核的通用 32 位微控制器(MCU)。相关产品具备宽电压工作范围、低功态功耗、低待机电流及高性价比等特点,并集成 ADC、RTC、比较器、多通道 UART 等多种模拟与数字外设。产品支持休眠和深度休眠两种低功耗模式,其中深度休眠模式可在约 3μs 内快速唤醒,系统动态功耗低于 100μA/MHz,深度休眠功耗低于 1μA。目前,公司已基本完成通用低功耗 MCU 产品线布局。ZB32L003、ZB32L031、ZB32L032 系列产品覆盖 20PIN 一 48PIN 多种封装规格,可满足不同应用场景需求。

报告期内,公司同步推进基于 M0+ 内核的电机控制 MCU 产品 ZB32M013、ZB32M033 的市场推广,公司研发团队完成新一代核心 IP 模块的优化与验证,持续加强在低功耗设计、电机控制融合及多场景适配等关键技术领域的研发。通过与产业链合作伙伴的协同,公司在工艺适配、电机控制算法优化等方面取得进展,并持续推进 MCU 产品生态建设。目前,公司已与国内部分家电及消费电子客户开展定制化合作,并已建立起意向订单储备。

(2.3)大容量存储产品业务

a.SPI NAND

2025 年公司已量产主流 24nm 原厂晶圆搭载一颗 SPI 接口 controller 的产品,其产品内置 ECC 纠错算法,ECC 纠错能力可达 8b/512B,相比传统 single die 方案产品,额外搭载 SPI 控制器中固件可更好的使其满足数据传输效率的同时,可提供更高的可靠性和稳定性,以满足客户复杂的应用场景需求。2026 年上半年公司将量产一款性价比更高的产品,可以满足不同细分领域客户对产品性能和价格的不同需求。

b.SD NAND

2025 年公司已量产主流 24nm 原厂晶圆搭载一颗 SPI 接口 controller 的产品,提供定制化 Firmware,ECC 纠错能力可达 8b/512B。相较 TF card 产品,产品尺寸更小,同时 WSON8 的封装使其满足数据传输效率的同时,可提供更高防震性,以避免存在晃动场景造成的接触不良。目前公司正在搭载主流 1xnm 晶圆研发一款新的产品,以确保产品价格和供应的竞争力。

c.PPI NAND

采用 24nm 原厂晶圆内置 ECC Engine,ECC 纠错能力可达 8bit/512Byte,兼容 x8 和 x16 的并行接口,完全满足客户大数据量的读写。同时提供 BGA24、BGA63 和 TSOP48 多种封装形式的产品,以满足客户的不同封装需求。

d.eMMC 产品

随着智能终端设备对存储容量和性能要求的提升,为了满足客户对高速数据传输和稳定运行的需求,基于主流闪存芯片打造的 eMMC 5.1 嵌入式存储产品,最大顺序读取速度达 320MB/s,支持动态 SLC 缓存,为终端设备提供稳定高性能。同时内置固件算法提供自动后台检测、磨损平衡、垃圾回收、纠错算法 LDPC 等,确保了产品的低延迟、高数据保持性和长使用周期。产品涵盖 4GB、8GB、32GB、64GB、128GB、256GB 多种容量设计,能够为智能电视、IPC、手机终端、以及其他 AIoT 等不同终端客户,提供不同容量的高性能、高可靠性的存储解决方案。

e.DRAM 产品

DDR4 产品凭借其高带宽、低功耗和稳定性能,成为主流内存解决方案。2025 年公司积极布局易失性存储芯片 DRAM 内存产品,采用模组合作模式,致力于实现易失性和非易失性利基型产品的全覆盖。公司 DDR4 产品在 2025 年上半年量产。产品也将涵盖主要容量 4Gb 和 8Gb,产品速率最高可达行业 DDR4 最高的 3200Mbps,封装形式包含 BGA78 和 BGA96,可满足主流客户的需求。同时公司已经在积极布局新的产品线 DDR5 和 LPDDR 产品,以满足客户的不同需求。

(2.4)AI 业务

公司 AI 业务产品主要包括通用 AI SoC 芯片、AI 通用算法模型、AI 定制算法模型开发和 AI 模组。

AI SoC 芯片,采用 RISC 内核,功能强大,适配性强,性价比高,2025 年实现大批量出货。

AI 算法软件,包括 TinyML 视频分割算法、TinyML 视觉识别算法、TinyML 语音识别算法、TinyML 语音声纹算法和 TinyML 语音降噪算法 5 大类别,具有模型精简、占用硬件资源少、能耗低的优势,广泛部署到通用 MCU/DSP 硬件上运行。

AI 模组,融合了芯片、算法产品以及软件部署技术,基于包含 Cortex-M 内核 MCU、Cortex-A 内核 CPU、RISC 内核 MCU 及 MCU+DSP 核的 MCU 等模组板卡硬件计算平台,持续推出不同场景应用、多种硬件平台的软硬一体 AI 模组板卡产品。公司不同系列产品能够既用于 AI 音频功能实现,满足 AI 语音识别、AI 声纹识别、AI 语音降噪等应用场景需求,又能用于 AI 视频功能实现,满足 AI 图像分割、图像识别及视觉动作分析等应用场景需求。

2.2 主要经营模式

自成立以来,公司的经营模式一直为 Fabless 模式,专注于芯片的研发、设计和销售,晶圆代工、晶圆测试和芯片封测等环节通过委外方式实现。公司采用目前经营模式有利于公司集中资源进行芯片设计研发,快速实现产品布局和更新迭代,及时适应市场变化,满足客户需求,从而充分发挥公司的竞争优势,同时避免巨额资金投入,降低公司的经营风险。此外,公司采用 Fabless 经营模式,可根据不同晶圆代工厂工艺制程特点来定义自身产品的技术路线,实现差异化竞争并弥补不同晶圆代工厂在品质、良率和产能方面的不足。未来公司经营模式预计不会发生变化。公司具体的盈利、研发、采购、生产及销售模式如下:

(1)、盈利模式

公司是一家采用 Fabless 模式的集成电路设计企业,主要向客户提供自主品牌的 NOR Flash 和 MCU 等芯片产品获取业务收入从而实现盈利。

(2)、研发模式

公司产品以自主研发为主,同时会与晶圆代工厂进行深入合作,充分利用其工艺优势,并针对工艺上的缺陷,在产品设计上进行弥补。

(3)、采购和生产模式

公司的经营模式为 Fabless 模式,该模式下公司专注于芯片的研发、设计和销售,晶圆代工、晶圆测试和芯片封测等均通过委外方式实现。

公司晶圆代工厂主要为武汉新芯和中芯国际,并与之建立了长期稳定的合作关系。晶圆测试和芯片封装测试的市场供应商相对较多,产能相对充足。根据客户对产品形态要求不同,公司的芯片产品可分为晶圆片(KGD)和封装片,晶圆片是指由晶圆代工厂生产完成并经晶圆测试(CP),但未经过芯片封装测试的产品;封装片则是在完成晶圆测试后,还要进行芯片封装(Packaging)和最终测试(FT)形成的产品。对于具有合并封装(SIP)需求的主控芯片厂商,则需要采购晶圆片,再按照自身具体要求将采购的晶圆片上的裸芯片(Die)取下后与其他芯片合并封装。晶圆片和封装片在芯片电路和制造工艺等方面不存在差异。

(4)、销售模式

公司采用直销和经销两种销售模式。直销模式下,终端客户直接向公司下达采购订单。经销模式下,经销商根据终端客户需求向公司下达采购订单,公司与经销商之间为买断式销售。公司根据芯片的市场价格与客户协商定价。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务为芯片的研发、设计和销售,根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》,公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”,属于新一代信息技术领域,行业代码为“C39”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”,行业代码“6520”。公司目前主要营收来源于 NOR Flash 存储芯片业务。

2025 年全球存储器行业继续呈现结构性增长与供需失衡并存的态势,AI、大数据、物联网(IoT)、智能汽车、工业控制等下游应用对存储芯片的需求快速增长推动整体市场规模稳定扩大。在细分产品中,NOR Flash 作为高可靠性、低功耗且具备快速随机读写能力的非易失性存储器,仍在工业与车载控制等场景保持稳定需求增长。根据 Mordor Intelligence 的报告,2025 年全球 NOR Flash 市场规模为 30.5 亿美元,2026 年预计达 32.3 亿美元,2026 至 2031 年将以 5.76% 的复合年增长率持续增长,到 2031 年市场规模将达到 42.7 亿美元。

在价格方面,2025 年下半年 NOR Flash 价格开始回暖。一方面,头部厂商由于 AI、车规工业等高端领域对大容量 NOR Flash 的持续拉动,加大投入,使得 NOR Flash 在整体成熟制程存储价格上涨周期中表现出价格上行趋势;另一方面,晶圆代工产能及封装产能的高景气度,使得供给端价格上涨。根据市场行情来看,2025 下半年以来 NOR Flash 单品价格相较 2024 年整体上涨,部分主力产品(如中大容量 NOR Flash)在下游积极备货的需求窗口下已实现价格上调,同时预计对 2026 年整体价格趋势保持乐观态度。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(2.1)NOR Flash 业务

公司长期专注于 NOR Flash 存储芯片的研发设计,在核心架构、电路设计及低功耗技术等方面形成了一定技术积累,在工作频率、可靠性、温度范围等关键指标方面与行业主流水平保持一致,部分型号在读写、擦除电流等功耗指标方面具有一定优势。整体技术水平处于国内厂商较为领先的位置,部分产品指标达到行业先进水平。公司 NOR Flash 产品已实现 50nm、55nm 制程量产,并于 2025 年顺利量产 NORD 架构小容量产品,制程和技术水平与行业主流厂商处于相近水平。

(2.2)MCU 业务

当前全球 MCU 市场仍由国际厂商主导,高端应用领域主要由意法半导体(ST)、恩智浦(NXP)、瑞萨电子(Renesas)等企业占据主要份额,国产厂商正通过技术研发和产品迭代逐步提升市场竞争力。

公司 MCU 业务处于发展阶段,围绕 ARM Cortex-M0+ 内核持续推进产品升级与系列化布局,同时开始在电机专用市场开始研发布局,加大在家电控制、工业控制及汽车电子等领域的市场拓展力度。随着产品线不断丰富和客户基础逐步扩大,公司 MCU 业务规模预计持续增长,市场影响力将稳步提升。

(2.3)大容量存储业务

公司自 2024 年开展大容量存储业务,目前该业务还处于起步阶段,在利基市场初步完成产品卡位,但目前体量尚小,技术实力尚在追赶。未来,公司的地位变化高度依赖战略执行与突围成效,将不断开发新的原厂资源,丰富产品种类,持续扩展客户和提高市场份额,逐步成为公司新的业务增长方向。

(2.4)AI 业务

公司围绕端侧 AI 应用方向开展业务布局,形成了涵盖 AI 算法、AI 模组及端侧 AI 解决方案的产品体系,其中 AI 算法和 AI 模组产品已实现商业化落地。在 AI 产品商业化方面,公司在照明灯控、玩具和家电等行业持续扩大市场份额,成为头部客户供应商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(3.1)NOR Flash

在新技术方面,NOR Flash 主要采用 ETOX、SONOS 和 NORD 三种技术架构。其中,ETOX 架构凭借成熟的量产经验及自主知识产权,仍为当前主流技术路线;SONOS 架构在小容量产品中具有一定优势,但通常涉及国外厂商授权;NORD 架构近年来在晶圆厂推动下快速发展,在小容量产品领域逐步展现竞争优势。在制程方面,ETOX 主流工艺已由 65nm 向 5xnm 节点演进,基于 5xnm 工艺的产品已逐步实现规模量产并在多数消费电子领域替代 65nm 产品,部分领先厂商正在推进 4xnm 节点研发。NORD 架构产品则由 90nm 向 65nm、55nm 节点持续升级。整体来看,NOR Flash 技术正向低功耗、低电压、高性能及更高容量方向发展,其中 NORD 架构在编程效率、擦除速度及功耗控制方面具有一定优势。

在新兴产业方面,NOR Flash 的市场需求不仅来自传统消费电子产品的升级换代,还受益于可穿戴设备、AMOLED 智能手机、物联网设备、5G 基站、新能源汽车及智能终端等领域的快速发展。国内厂商依托较高性价比逐步进入市场,并通过提升产品容量及制程水平形成一定竞争优势。

未来,随着国内企业在技术与资金方面的持续积累,行业有望通过优化芯片设计、升级制程工艺及提升生产效率实现成本与性能优势,并逐步向中高容量产品及工业控制、汽车电子、服务器等高附加值应用领域拓展。随着汽车智能化和 AI 技术的发展,车规级 NOR Flash 与 AI 服务器存储需求预计将持续增长。

(3.2)MCU

在新技术方面,MCU 正由传统通用控制芯片向面向垂直应用场景的系统级解决方案发展。厂商通过异构计算架构、先进封装与嵌入式存储技术,并结合完善的软件生态,在保证低功耗的同时提升实时计算和智能处理能力。

在新兴产业方面,MCU 的需求主要来自工业自动化与能源系统、智能家居与物联网设备以及智能终端与消费电子产品等领域。其中,工业与能源应用对 MCU 的实时控制能力要求较高,需要具备高精度 PWM、快速 ADC 及高可靠性控制能力;智能终端设备则推动端侧 AI 能力与低功耗计算的融合发展。

在新业态方面,电机控制技术成为 MCU 重要发展方向之一。随着直流无刷电机、智能机器人及自动化设备的快速发展,市场对电机控制芯片的定制化设计及控制算法能力提出更高要求。

在新模式方面,MCU 行业逐步形成“芯片 + 软件 + 算法”一体化解决方案的发展模式,通过完善开发工具链与应用生态,降低客户开发门槛并提升产品竞争力。未来 MCU 技术将持续向低功耗、高安全性、低成本、高可靠性及智能化方向发展。

(3.3)大容量存储业务

随着半导体工艺不断逼近物理极限,存储技术的发展正逐步由单纯依赖制程微缩向架构优化、材料创新及先进封装等多维技术路径协同推进。在 DRAM 领域,先进制程持续向更小节点演进,同时高带宽存储(HBM)通过三维堆叠和先进封装实现更高带宽与更低延迟,成为人工智能计算的重要支撑;在 NAND Flash 领域,3D 堆叠层数不断提升,但行业发展逐步由单纯增加堆叠层数转向架构优化和单位存储效率提升,以进一步降低单位存储成本并提高可靠性。此外,MRAM、ReRAM 等新型存储技术在部分高可靠性和嵌入式应用场景中逐步得到应用,与传统存储技术形成互补发展格局。

与此同时,人工智能、云计算及智能终端的发展持续带动存储需求结构升级,高性能计算和 AI 服务器对高带宽内存及高性能存储产品的需求明显提升,而消费电子产品功能升级也推动终端设备对存储容量和性能提出更高要求。在应用场景不断扩展的背景下,存储产业链合作模式持续深化,模组厂商逐步由单一产品集成向系统级解决方案提供者转变,通过主控方案优化、固件开发及应用适配能力,为终端客户提供更完整的产品解决方案。总体来看,在人工智能和数字化应用快速发展的推动下,存储行业正由以规模和周期为主导的发展模式逐步向以技术创新和应用价值为核心的发展阶段演进。

(3.4)AI 业务

近年来,端侧 AI 与生成式 AI 应用持续发展,端云协同架构的重要性不断提升。端侧设备通过本地 AI 算法实现实时感知与隐私保护,云端则依托大模型能力提供更复杂的智能服务,形成端云协同的 AI 应用模式。

随着生成式 AI 技术的发展,终端设备对语音交互、环境感知及自学习能力的需求持续提升,相关算法(如语音自学习、回声消除等)逐步在智能家电、可穿戴设备、消费电子及智能玩具等 AIoT 产品中得到应用,并与云端大模型形成互补。

未来,端侧 AI 将围绕离线化、实时化和本地自主决策能力持续演进,通过端云一体化交付、场景化定制及“硬件 + 服务”融合模式推动产业发展。随着技术进步,AI 系统将进一步向低功耗、高安全性、端云协同与深度应用实体经济方向发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,364,058,662.45	1,478,736,716.97	-7.76	1,657,008,240.42
归属于上市公司股东的净资产	1,268,975,079.19	1,363,661,578.73	-6.94	1,528,707,599.61
营业收入	474,649,558.92	372,290,141.86	27.49	305,838,597.59
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	474,649,558.92	372,290,141.86	27.49	305,838,597.59
利润总额	-99,423,478.23	-161,097,819.87	不适用	-170,455,344.57
归属于上市公司股东的净利润	-99,493,886.89	-160,998,939.75	不适用	-172,639,293.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,241,520.58	-178,563,319.34	不适用	-191,629,853.22
经营活动产生的现金流量净额	109,317,709.09	-122,036,946.93	不适用	-166,056,797.82
加权平均净资产收益率(%)	-7.67	-11.08	增加 3.41 个百分点	-10.72
基本每股收益(元/股)	-1.21	-1.95	不适用	-2.09
稀释每股收益(元/股)	——	——	不适用	——
研发投入占营业收入的比例(%)	24.20	27.19	减少 2.99 个百分点	32.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	75,141,208.77	99,133,898.02	131,636,979.32	168,737,472.81
归属于上市公司股东的净利润	-26,331,483.10	-44,450,943.47	-24,546,724.37	-4,164,735.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,885,050.77	-46,374,335.39	-28,864,789.82	-8,117,344.60
经营活动产生的现金流量净额	20,886,867.61	19,489,279.71	18,402,708.98	50,538,852.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,373
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,994
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
XIANGDONG LU	0	10,828,156	13.06	10,828,156	无	0	境外自然人
吕铁南	0	6,864,800	8.27	6,864,800	无	0	境内自然人
合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙)	0	6,798,200	8.19	0	无	0	其他
董翔羽	-829,294	5,244,188	6.32	0	无	0	境内自然人
孟祥巍	-510,669	2,312,813	2.79	0	无	0	境内自然人
孙丰	1,881,071	1,881,071	2.27	0	无	0	境内自然人
合肥中安沪阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,950,634	1,828,304	2.20	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,574,226	1,475,501	1.78	0	无	0	其他
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	909,646	909,646	1.10	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	661,396	806,272	0.97	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		XIANGDONG LU 直接持有公司 13.06% 的股份,通过合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 8.19% 的股份;吕铁南直接持有公司 8.27% 的股份;XIANGDONG LU 与吕铁南为兄弟关系,并签署《一致行动协议》,二人共同控制公司 29.51% 的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外,公司未知前其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

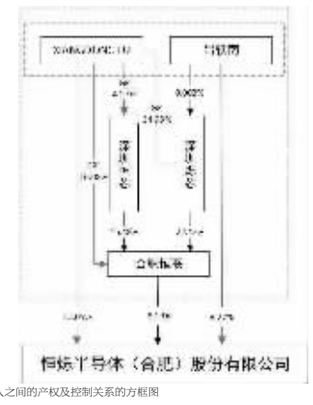
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

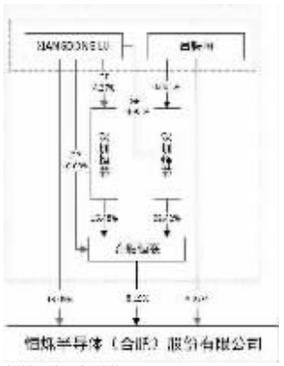
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业总收入 47,464.96 万元,同比增长 27.49%;实现归属于母公司所有者的净利润 -9,949.39 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -11,424.15 万元。影响经营业绩的主要因素:

(1)、报告期内,公司维持原有市场销售政策,以出货量和市场份额为关键,加大销售力度,相较于去年同期产品出货量增加,同时受益于行业整体的向好发展,公司营业收入及综合毛利率同比有一定增长,但相较于现有营收规模综合毛利率仍处于较低水平;

(2)、报告期内,公司继续坚持团队建设,持续进行研发投入和产品迭代,进一步丰富产品结构和新产品研发,公司期间费用率仍处在较高水平;

(3)、报告期内,下游市场的景气度提升,公司所处行业市场供求关系向好,公司本年计提的资产减值损失金额较上年同期显著减少,但对公司净利润仍有较大影响。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2026-014

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及公司内部制度规定,结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素,对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)进行确认,同时制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体情况如下:

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬(津贴)情况如下:

序号	姓名	职务	金额(万元)
1	XIANGDONG LU	董事长、总经理	103.31
2	吕铁南	董事	0.00
3	任军	董事、副总经理	96.72
4	文冬梅	独立董事	10.00
5	贺平	独立董事	10.00
6	赵新林	副总经理	96.46
7	周晓芳	副总经理、董事会秘书	42.08
8	唐文红	财务总监	42.19

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用范围

公司 2026 年度任职内董事(含独立董事)、高级管理人员

(二)适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三)薪酬方案

1、董事薪酬方案

董事薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

(1)公司独立董事领取固定的独立董事津贴,独立董事津贴为 10 万元/年(含税),按季度发放。

(2)公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放。绩效薪酬以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础,部分绩效薪酬根据目标拆解按季度、半年度考核发放;其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(3)未在公司任职且未签订劳动合同的非独立董事,不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(1)基本薪酬:主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放。

(2)绩效薪酬:以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础,部分绩效薪酬根据目标拆解按月度、季度、半年度考核发放;其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(四)其他事项

1、上述薪酬或津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬或津贴中扣除下列事项,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴个人所得税。

(1)代扣代缴个人所得税。

(2)各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。

(3)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

(五)审议程序

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议,其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》因涉及全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,关联委员回避表决。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事就本议案回避表决,本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,关联董事回避表决。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2026-016

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 11 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼)会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 11 日

至 2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的